

а 2014 0071

Изобретение относится к технике оксидных полупроводников, в частности к газовым сенсорам на основе оксида молибдена.

Газовый сенсор на основе  $\text{MoO}_3$  включает диэлектрическую подложку, на одной стороне которой расположен чувствительный слой из  $\text{MoO}_3$ , с нанесенными на него омическими контактами, формирующими чувствительную зону, а на противоположной поверхности подложки нанесен нагревательный элемент. Чувствительный слой выполнен в виде нанокристаллической полоски с толщиной 150 нм и шириной чувствительной зоны 150  $\mu\text{м}$ .

П. формулы: 1

Фиг.: 4